Silicon Diode

BAW76

50V / 300mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

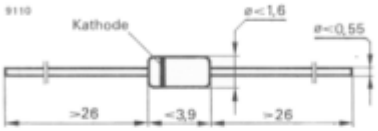
Source: Telefunken Databook 1988

BAW 76

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Abmessungen in mm



Standard Glasgehäuse
54 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Periodische Spitzensperrspannung	U_{RRM}	75	V
Sperrspannung	U_R	50	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 1\ \mu s$	I_{FSM}	2000	mA
Periodischer Durchlaßspitzenstrom	I_{FRM}	500	mA
Durchlaßstrom	I_F	300	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert $U_R = 0$	I_{FAV}	150	mA
Verlustleistung $l = 4$ mm, $T_L = 45$ °C	P_V	440	mW
$T_L \leq 25$ °C	P_V	500	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	−65 ... +200	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung $l = 4$ mm, T_L = konstant	R_{thJA}	350	K/W

BAW 76

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25$ °C, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung					
$I_F = 100$ mA	U_F			1	V
Sperrstrom					
$U_R = 50$ V	I_R			100	nA
$U_R = 50$ V, $T_j = 150$ °C	I_R			100	µA
Durchbruchspannung					
$I_R = 5$ µA	$U_{(BR)}$ [1]	75			V
Diodenkapazität					
$U_R = 0$ V, $f = 1$ MHz, $U_{HF} = 50$ mV	C_D		1,7	2	pF
Rückwärtserholzeit					
$I_F = I_R = 10$ mA, $i_R = 1$ mA	t_{rr}			4	ns
$I_F = 10$ mA, $U_R = 6$ V, $i_R = 1$ mA, $R_L = 100\ \Omega$	t_{rr}			2	ns

[1] $\frac{t_p}{T} = 0.01$, $t_p = 0.3$ ms